

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2552596

ДАТЧИК ВТОРИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2012143862

Приоритет изобретения **16 октября 2012 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации **07 мая 2015 г.**

Срок действия патента истекает **16 октября 2032 г.**

Врио руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Л.Л. Кирий



Автор(ы): *Надирадзе Андрей Борисович (RU), Шапошников
Владимир Владимирович (RU)*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(21)(22) Заявка: 2012143862/28, 16.10.2012

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
16.10.2012

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 16.10.2012

(43) Дата публикации заявки: 27.04.2014 Бюл. № 12

(45) Опубликовано: 10.06.2015 Бюл. № 16

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: Шульман А.Р., Фридрихов С.А., Вторично-эмиссионные методы исследования твердого тела. - М.: "Наука", 1977, с.507. US 4405861A, 20.09.1983. SU 879672A1, 07.11.1981. SU1681209A1, 30.09.1991. RU 2124716C1, 10.01.1999. GB 1403946A, 28.08.1975

Адрес для переписки:

125993, Москва, А-80, Волоколамское ш., 4,
МАИ, Патентный отдел

(72) Автор(ы):

Надирадзе Андрей Борисович (RU),
Шапошников Владимир Владимирович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Московский авиационный институт
(национальный исследовательский
университет)" (МАИ) (RU)

RU
2 5 5 2 5 9 6
C 2

(54) **ДАТЧИК ВТОРИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ**

(57) Формула изобретения

Датчик вторичной электронной эмиссии, включающий электростатический селектор электронов по энергиям, регистратор электронов, установленный на выходе из селектора и содержащий последовательно расположенные сцинтиллятор в виде слоя люминофора с управляющей металлической сеткой и фотоэлектронный умножитель с входным светопроницающим окном, отличающийся тем, что слой люминофора нанесен на поверхность входного светопроницающего окна фотоэлектронного умножителя, а управляющая сетка размещена внутри этого слоя, при этом толщина сетки не превышает толщины слоя люминофора, а ее геометрическая прозрачность составляет 0,6...0,9.